

第三届全国集成电路和硅材料学术年会在合肥召开

中国电子学会半导体与集成技术学会和中国电子学会电子材料学学会联合举办的第三届全国集成电路和硅材料学术年会于1983年11月9日至13日在安徽省合肥市召开。来自全国各工业部、高等院校、中国科学院和工厂一百二十多个单位的三百名专家、学者、工程技术人员出席了年会。

年会特邀有关专家、教授王守武、林兰英、黄敞、李志坚、宋秉治、万群作学术报告。年会按专业分六个分会场进行交流。宣读、书面交流250篇论文报告,其中硅材料63篇,双极电路25篇,MOS电路46篇,器件工艺78篇,理化分析测试38篇。在硅材料研究方面,有关直拉硅单晶中原生缺陷的研究,硅中氧碳及热处理行为的研究,硅中内吸除效应的研究均有可喜的进展。在集成电路方面,4K静态存储器、16K动态存储器,16K KEPRAM以及Cμ 8085A等是我国目前具有较高水平的电路,四位微处理器CPU,1KRAM已开始批量生产,通讯电路,线性电路等研究也逐步开展。采用氧化物隔离的双极型CL100K电路及低功耗肖特基TTL电路的研制也有所突破。在集成电路工艺方面,如低缺陷优质薄栅氧化技术、浅结工艺、低压CVD,激光退火、新型合金系统、表面钝化和离子注入技术的研究取得了较好的成果。在理化分析测试方面,新的测试方法、新的测试仪器的研制有可喜的成果,微处理器、计算机、激光技术,俄歇能谱等新技术的应用也见成效。总之,这次年会是对我国近两年来半导体集成电路和硅材料的新进展新成果的一次检阅。

年会期间,还应东道主合肥晶体管厂邀请组织了部分专家、学者、教授和科技人员对该厂生产中出现的一些工艺技术问题进行了技术会诊与座谈讨论,受到厂方及有关领导的欢迎。安徽省委、省政府的领导同志出席了年会,并在开幕式上致词祝贺。

(冯应章)

Third National Conference on Integrated Circuits and Silicon Materials

Hefei, Anhui, China, Nov. 9—13, 1983